

【2020年度第1回 e-卓越cafe】

2020.11.17 Zoom開催の様子

日時：11月17日(火)14:00～15:00

講演者：立木 馨大さん（電子工学専攻・木本研究室・博士後期課程2回生）

実施形式：オンライン開催（Zoom等）

タイトル：SiC/SiO₂ 高密度界面欠陥の低減を目指した一学生の軌跡

参加者数：19名（学生13名（講演者含む）、教員3名、事務職員3名）

Press release 10/17

京大が再び快挙：
SiC-MOSFETの電子移動度が倍増、20年ぶりに大幅向上 (1/2)

2020年09月09日 09時30分 公開

印刷する

熱酸化なし、NOガス不

SiC MOSFET特性(移動度)改善の変遷

年	電子移動度 (cm²/Vs)	正孔移動度 (cm²/Vs)
1990	0	0
1995	10	5
2000	20	10
2005	30	15
2010	40	20
2020 (今回の成果)	20	15

Keita Tachiki

当初の目標はクリアしたが
本当にSiC側欠陥の除去が主たる界面準位低減の効果であるのか実は、まだ疑っている

Zoom ミーティング

光電子卓越大学院 Masahiro Hara Keita Tachiki Mitsuru Kaneko

研究者に必要な能力とは何？ 13/17

絶対に必要なこと

1. 基礎知識
2. 実際の研究 (実験、解析、計算等)

副次的に必要なこと

1. 発表能力
2. 論文執筆能力
3. 資金集め

これらは絶対に必要なの？
これらが必要なことを幼少期していた？

参加者 (19)

光電子卓越大学院 (自分)

Ryoya Ishikawa

Tsunenobu Kimoto

具 燦淳

佐 佐藤 瑞起

信 楽裕子

野 野本健斗

招待 ミュート解除します 手を挙